

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2017

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

- Интегрированные алмазные сенсоры с оптическим управлением
А. В. Цуканов 247
-

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

- Влияние особенностей конструкции изолирующей щели открытых “Сэндвич”-структур $\text{TiN-SiO}_2\text{-W}$ и $\text{Si-SiO}_2\text{-W}$ на процесс их электроформовки
В. М. Мордвинцев, С. Е. Кудрявцев 266
- Расчёт высокочастотной электропроводности тонкого полупроводникового слоя в случае различных коэффициентов зеркальности его поверхностей
И. А. Кузнецова, Д. Н. Романов, О. В. Савенко, А. А. Юшканов 275
-

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Кинетика травления меди в ВЧ-разряде фреона R-12
А. В. Дунаев, Д. Б. Мурин 284
- Влияние состава смеси на электрофизические параметры и спектры излучения плазмы $\text{CF}_2\text{Cl}_2/\text{Ar}$ и $\text{CF}_2\text{Cl}_2/\text{He}$
С. А. Пивоваренок 290
-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Оптимизация омических контактов к n -слоям гетеробиполярных наногетероструктур на основе арсенида галлия
В. И. Егоркин, В. Е. Земляков, А. В. Неженцев, В. И. Гармаш 295
- Разработка методики локального легирования и коррекции проводимости эпитаксиальных слоёв PbSnTe путём диффузии индия из поверхностных нанометровых плёнок
Д. В. Ищенко, Б. М. Кучумов 301
-

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕМЕНТАХ И СИСТЕМАХ

- Диффузионная модель ионизационной реакции элементов БИС при воздействии ТЗЧ
А. В. Согоян, А. И. Чумаков 305
- Методика радиационной идентификации предприятия и характеристики технологии изготовления интегральных схем
А. В. Согоян, Г. Г. Давыдов, А. С. Артамонов, А. С. Колосова, В. А. Телец, А. Ю. Никифоров, Ю. А. Ожегин, А. С. Каменева, Ю. М. Московская 313
-